

"ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"

Редакционный совет
Главный редактор
Красников Г.Я., д.т.н.,
академик РАН

Члены редакционного совета

Аристов В.В.,
член-корреспондент РАН
Асеев А.Л., д.ф.-м.н.,
академик РАН
Бетелин В.Б., д.ф.-м.н.,
академик РАН
Бокарев В.П., к.х.н.,
ответственный секретарь
Бугаев А.С., д.ф.-м.н.,
академик РАН
Быков В.А., д.т.н.
Галиев Г.Б., д.ф.-м.н.
Горбачев А.А. д.ф.-м.н.,
член-корреспондент РАН
Горнев Е.С., д.т.н.,
зам. главного редактора
Грибов Б.Г., д.х.н.,
член-корреспондент РАН
Зайцев Н.А., д.т.н.
Ким А.К., к.т.н.
Критенко М.И., к.т.н.
Немудров В.Г., д.т.н.
Петричкович Я.Я., д.т.н.
Сигов А.С., д.ф.-м.н., академик РАН
Стемпковский А.Л., д.т.н.,
академик РАН
Чаплыгин Ю.А., д.т.н.,
член-корреспондент РАН
Шелепин Н.А., д.т.н.,
зам. главного редактора
Эннс В.И., к.т.н.

Адрес редакции

✉ 124460 г. Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
☎ +7 495 229-70-43
✉ journal_EEM-3@mikron.ru
🌐 www.niime.ru/
zhurnal-mikroelektronika
Журнал издается с 1965 года

Учредитель

АО "Научно-исследовательский
институт молекулярной
электроники"

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЯ

Г.Я. КРАСНИКОВ, О.П. ГУЩИН, М.В. ЛИТАВРИН, Е.С. ГОРНЕВ
DSA-комплементарный метод усиления разрешения
иммерсионной литографии 4–17

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Ф.И. ВЫСИКАЙЛО, В.С. МИТИН, А.Ю. ЯКОВЛЕВ, В.В. БЕЛЯЕВ
Модификация свойств наноструктурированных медь-углеродных
композитных покрытий 18–33

С.О. РАНЧИН, И.В. КИРЮШИНА

Свойства буферного травителя оксида кремния и особенности
использования в технологии интегральных схем 38–43

Н.А. КУЗНЕЦОВА, Р.Д. ЭРЛИХ, В.В. СОЛОВЬЕВ

Отечественный фоторезист для взрывной фотолитографии 44–46

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Г.Я. КРАСНИКОВ, Е.С. ГОРНЕВ., И.В. МАТЮШКИН

Общая теория технологии и микроэлектроника:
Часть 1. Уровни описания технологии 51–69

НАДЕЖНОСТЬ

А.В. МАРКИН

Особенности понятия "кратность воздухообмена" применительно
к чистым помещениям производственного назначения 70–78

АННОТАЦИИ 79–80